

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波増幅用

NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Amplifier

○オーディオアンプのプリドライバ用に最適です。

Suitable for driver of audio frequency amplifier applications.

○2SA915とコンプリメンタリで使用できます。

Complementary to PNP 2SA915.

○小形で全損失が大きく、高耐圧です。

$$P_T = 1.0W, V_{CEO} = 120V$$

Small package, high total power dissipation and high break-down voltage.

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	5.0	V
コレクタ電流(直流)	I _{C(DC)}	50	mA
コレクタ電流(パルス)	I _{C(pulse)*}	100	mA
全損失	P _T	1.0	W
ジャンクション温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C

*PW ≤ 10ms, duty cycle ≤ 50%

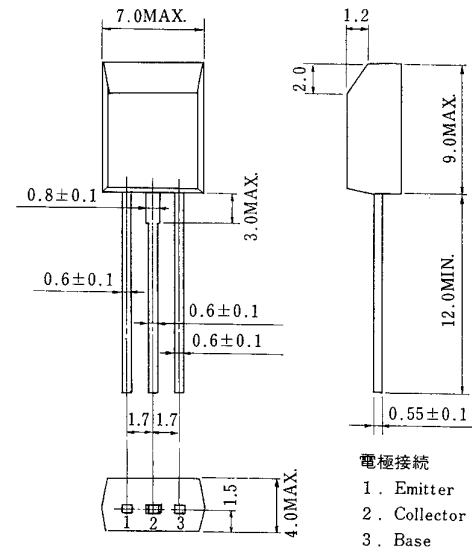
電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =120V, I _E =0			100	nA
エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5.0V, I _C =0			100	nA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA *	50	180		
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} =10V, I _C =10mA *	90	200	400	
直流ベース電圧	V _{BE}	V _{CE} =10V, I _C =10mA *	650	685	750	mV
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =20mA, I _B =2.0mA *		0.07	0.6	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =20mA, I _B =2.0mA *		0.75	1.0	V
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1.0MHz		2.3	3.0	pF
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =10V, I _E =-10mA	50	120		MHz

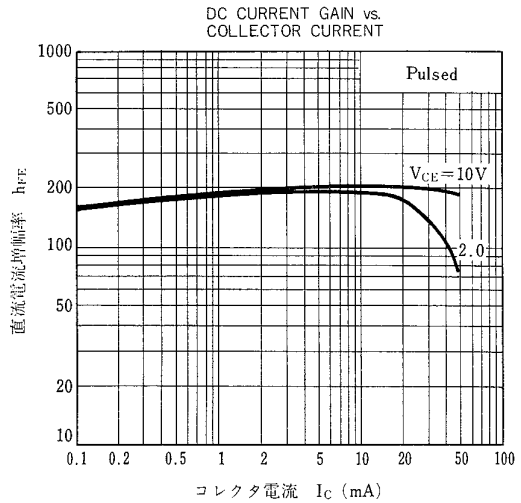
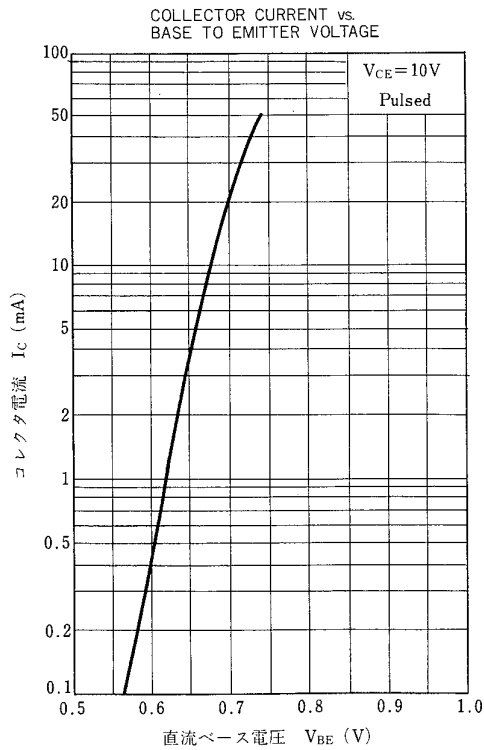
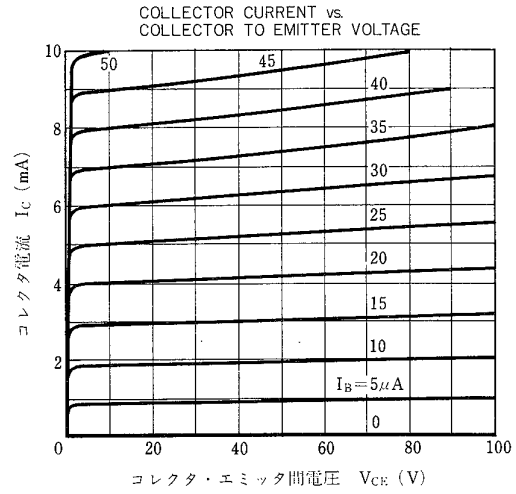
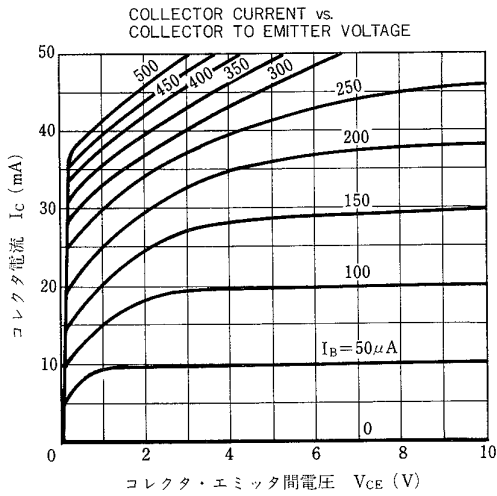
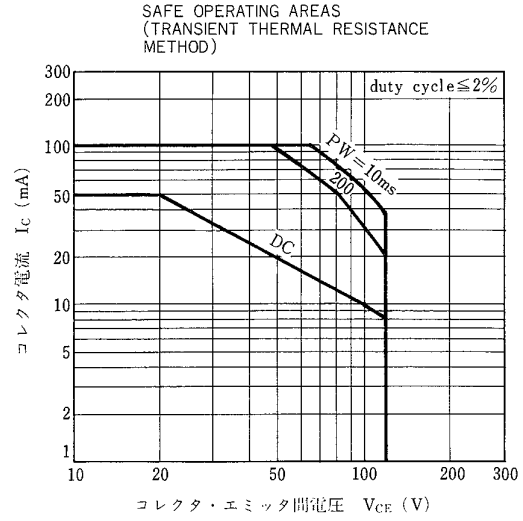
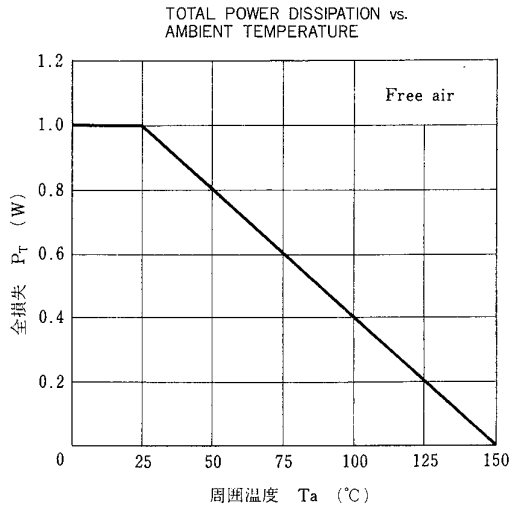
*パルス測定 PW ≤ 350 μs, duty cycle ≤ 2%/Pulsed

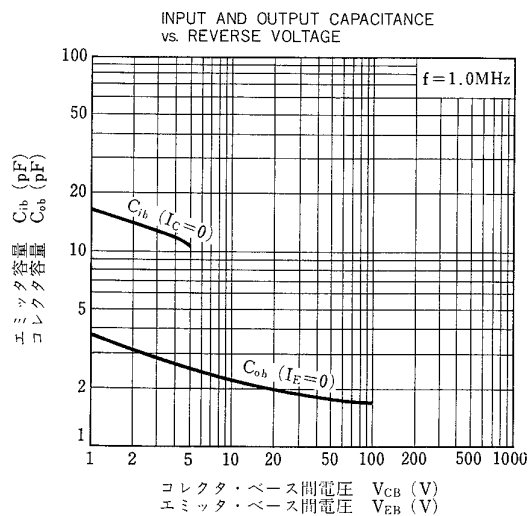
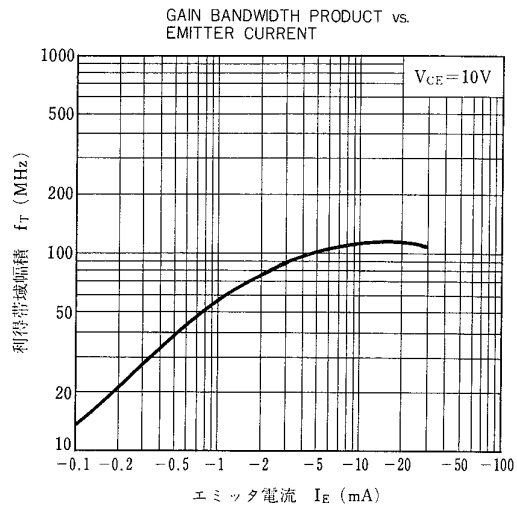
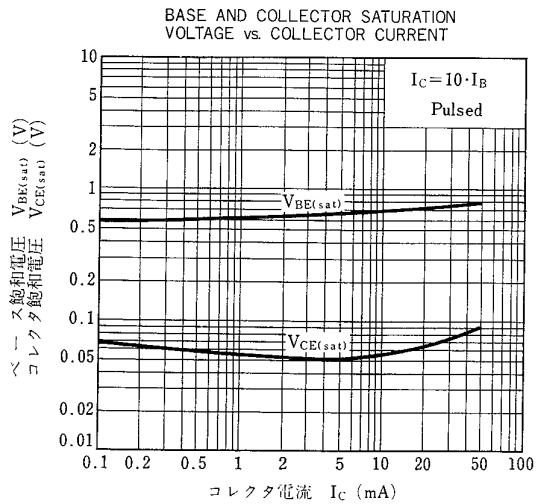
h_{FE2}区分★ / h_{FE2} Classification MA: 90~180 LA: 135~270 KA: 200~400

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)★



特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)





NEC 日本電気株式会社

Table listing NEC branch offices in the Kanto region (東京地区). Columns include office name, address, phone number, and fax number.

Table listing NEC branch offices in the Kansai region (近畿地区). Columns include office name, address, phone number, and fax number.